

Gassensor und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gassensor und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Halbleitergassensoren zur Gasdetektion sind in unterschiedlichen Ausführungsformen bekannt. Diese Gassensoren werden in Sicherheitssystemen im industriellen Umfeld und auch in den letzten Jahren verstärkt im Automobilbereich eingesetzt, wo Gassensoren beispielsweise zur automatischen Steuerung der Lüftungsklappen verwendet werden, um das Eindringen von Schadgasen in den Innenraum zu verhindern.

Die bekannten Gassensoren weisen eine gassensitive Schicht auf, welche unter Beaufschlagung von reduzierenden oder oxidierenden Gasen eine Änderung der Oberflächenleitfähigkeit und damit des elektrischen Widerstands erfährt. Diese Widerstandsänderung wird mittels einer geeigneten Auswertestruktur als Messsignal ausgewertet. Die Betriebstemperatur eines solchen Gassensors, welche beispielsweise mehrere 100°C beträgt, wird über eine integrierte Heizstruktur erzeugt, welche vielfach in Form einer Mäander ausgebildet ist. Um die Betriebstemperatur des Gassensors einzustellen und zu überwachen, ist zumeist ein Temperaturmesswiderstand im Bereich der Heizstruktur vorgesehen.

Die gassensitive Schicht besteht in der Regel aus einem halbleitenden Metalloxid wie etwa SnO<sub>2</sub> oder WO<sub>3</sub>. Eine Beeinflussung der Selektivität für einzelne Gase ist durch eine Dotierung der gassensitiven Schicht mit entsprechenden Dotierstoffen und durch die Wahl der Betriebstemperatur möglich.

Da der spezifische Widerstand der gassensitiven Schicht sehr hoch ist, besteht die Auswertestruktur in der Regel aus einer Interdigitalstruktur (IDT; „Interdigitated Transducers“), welche zwei koplanare, kamm- oder fingerartig ineinandergreifende Elektroden aufweist. Diese Ausgestaltung entspricht einer Parallelschaltung der zwischen den einzel-

nen Fingern unterschiedlicher Polarität gebildeten Widerstände, wodurch der Messwiderstand verringert und die Empfindlichkeit des Gassensors gesteigert wird.

Die bekannten Gassensoren sind vielfach mikromechanisch auf der Basis eines Halbleiter-

5 substrats hergestellte Membransensoren. Durch die Anordnung der Heizstruktur, der Auswertestruktur und der gassensitiven Schicht auf einer Membran wird die Wärmekapazität des Gesamtsystems verringert, was eine Reduzierung der Leistungsaufnahme des Gassensors mit sich bringt.

10 Bei der Herstellung eines derartigen Gassensors werden zunächst die Heizstruktur, die Auswertestruktur und gegebenenfalls ein Temperaturmesswiderstand im Bereich der Heizstruktur auf die Membran aufgebracht. Die Oberseite der Membran ist mit einer haftvermittelnden Schicht, in der Regel eine Oxidschicht, versehen, um eine zuverlässige Haftung dieser Strukturen auf der Membran zu gewährleisten. Nachfolgend wird eine Deckoxid-  
15 schicht abgeschieden, diese durch eine Oxidätzung mit Hilfe einer Ätzlösung großflächig im Bereich der Auswertestruktur bis zur Oberfläche der Auswertestruktur entfernt und dann die gassensitive Schicht aufgebracht.

Um sicherzugehen, dass die gesamte Oberfläche der Auswertestruktur von dem Deckoxid  
20 freigelegt ist und damit eine ganzflächige Kontaktierung mit der gassensitiven Schicht erreicht wird, wird die Oxidätzung des Deckoxids in der Regel mit einer Überätzzeit durchgeführt. Hierbei besteht jedoch die Gefahr eines Unterätzens der Auswertestruktur, da die zur Oxidätzung eingesetzte Ätzlösung die haftvermittelnde Oxidschicht unterhalb der Auswertestruktur erreichen und diese Schicht zum Teil angreifen kann. Hierdurch wird die  
25 Haftung der Auswertestruktur auf der Membran verringert, so dass sich die Auswertestruktur im Verlauf der Einsatzzeit des Gassensors von der Membran teilweise ablösen kann und somit eine zuverlässige Funktionsweise nicht mehr gewährleistet ist.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die Widerstandswerte der Auswertestruktur  
30 und insbesondere der Heizstruktur über die Einsatzzeit des Gassensors ändern können. Diese schleichende Veränderung des Gassensors, welche auch als elektrischer „Drift“ bezeichnet wird, ist Folge einer thermischen Stresseinwirkung, da der Gassensor im Betrieb in einem permanenten Zyklus zwischen zwei Arbeitstemperaturen arbeitet. Hierdurch

kommt es zu Materialumlagerungen innerhalb der Strukturen, beispielsweise zu einem Wandern von Korngrenzen oder einem Wachsen von Kristalliten, verbunden mit einer Widerstandänderung. Die elektrische Drift tritt insbesondere bei im Automobilbereich eingesetzten Gassensoren auf, da hier die je nach Verwendung stark schwankenden Umgebungstemperaturen zwischen beispielsweise  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $150^{\circ}\text{C}$  zusätzliche thermische Belastungen hervorrufen können.

Bei der Auswertestruktur, welche sehr hohe Widerstandswerte der gassensitiven Schicht beispielsweise im  $\text{M}\Omega$ -Bereich misst, kann die Widerstandsänderung vernachlässigt werden. Gerade bei der Heizstruktur führt die Widerstandsänderung jedoch zu einer Veränderung der Heizleistung und damit der Betriebstemperatur des Gassensors. Ebenfalls betroffen von der Widerstandsänderung ist der im Bereich der Heizstruktur angeordnete Temperaturmesswiderstand, wodurch die exakte Temperatur des Gassensors nicht mehr bestimmt werden kann.

Infolgedessen verhindert die elektrische Drift eine zuverlässige stabile Funktionsweise über die Einsatzzeit der Gassensoren. Die Gassensoren könnten zwar in bestimmten Zeitabständen ersetzt oder einer Neukalibrierung unterzogen werden, was jedoch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist. Insbesondere im Automobilbereich ist diese Vorgehensweise daher nicht praktikabel.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen verbesserten Gassensor, welcher sich durch eine zuverlässige Funktionsweise auszeichnet, und ein entsprechendes Verfahren zu dessen Herstellung bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird durch einen Gassensor gemäß den Ansprüchen 1 oder 3 bzw. durch ein Verfahren gemäß den Ansprüchen 10 oder 12 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Erfindungsgemäß wird ein Gassensor der eingangs genannten Art mit einer auf einem Halbleitersubstrat ausgebildeten Membranschicht, auf der eine metallische Auswertestruktur in einem Auswertebereich und eine metallische Heizstruktur außerhalb des Auswertebereichs angeordnet sind, und mit einer über der Auswertestruktur und der Heiz-

struktur angeordneten gassensitiven Schicht vorgeschlagen, bei welchem die Heizstruktur auf einer haftvermittelnden Oxidschicht auf der Oberseite der Membranschicht angeordnet und durch eine Deckoxidschicht von der gassensitiven Schicht getrennt ist, wobei in dem Auswertebereich eine gegenüber einer Oxidätzung unempfindliche Haftvermittlerschicht 5 zwischen der Membranschicht und der Auswertestruktur angeordnet ist.

Durch die Verwendung dieser Haftvermittlerschicht im Auswertebereich anstelle der herkömmlichen haftvermittelnden Oxidschicht lässt sich die Gefahr eines Unterätzens der Auswertestruktur bei der Oxidätzung der Deckoxidschicht während der Herstellung des 10 Gassensors wirksam vermeiden, wodurch eine dauerhafte Haftung der Auswertestruktur auf der Membranschicht und damit eine zuverlässige Funktionsweise des Gassensors erzielt wird.

In der für die Praxis relevanten Ausführungsform ist die Haftvermittlerschicht entsprechend der Auswertestruktur strukturiert, um störende parallele Kriechströme über die Haftvermittlerschicht, welche beispielsweise bei Verwendung einer halbleitenden Haftvermittlerschicht auftreten, zu unterdrücken. 15

Erfnungsgemäß wird ferner ein Gassensor mit einer auf einem Halbleitersubstrat ausgebildeten Membranschicht, auf der eine metallische Auswertestruktur in einem Auswertebereich und eine metallische Heizstruktur außerhalb des Auswertebereichs angeordnet sind, und mit einer über der Auswertestruktur und der Heizstruktur angeordneten gassensitiven Schicht vorgeschlagen, bei welchem die Heizstruktur auf einer haftvermittelnden Oxidschicht auf der Oberseite der Membranschicht angeordnet und durch eine Deckoxidschicht 20 von der gassensitiven Schicht getrennt ist, wobei die Auswertestruktur in dem Auswertebereich entsprechend der Heizstruktur durch die Deckoxidschicht von der gassensitiven Schicht getrennt ist und die Deckoxidschicht Kontaktlöcher aufweist, welche jeweils einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur freilegen, um einen direkten Kontakt 25 zwischen der Auswertestruktur und der gassensitiven Schicht herzustellen.

30 Auch diese Ausgestaltung eines Gassensors gewährleistet eine zuverlässige Funktionsweise, da bei der Herstellung des Gassensors Kontaktlöcher in die Deckoxidschicht geätzt werden, welche jeweils nur einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur

freilegen, so dass die haftvermittelnde Oxidschicht unterhalb der Auswertestruktur bei dieser Oxidätzung der Deckoxidschicht nicht angegriffen wird und somit eine beständige Haftung der Auswertestruktur auf der Membranschicht erzielt wird.

5 Da die aufgebrachte gassensitive Schicht bei der Herstellung des Gassensors einem Sinterprozess unterzogen werden kann und dabei insbesondere an den Übergangsbereichen zwischen der durch die Deckoxidschicht bedeckten und der über die Kontaktlöcher freigelegten Oberfläche der Auswertestruktur unterschiedliche thermomechanische Spannungen auftreten, welche Materialumlagerungen innerhalb der Auswertestruktur oder sogar ein  
10 teilweises Auseinanderreißen der Auswertestruktur hervorrufen können, besteht die Deckoxidschicht in einer bevorzugten Ausführungsform wenigstens in dem Auswertebereich der Auswertestruktur aus einem stöchiometrischen Oxid. Dieses stöchiometrische Oxid, welches eine schlechtere Anbindung an die Auswertestruktur aufweist als ein einen gerin-  
15 geren Sauerstoffanteil aufweisendes unterstöchiometrisches Oxid, koppelt eine geringe thermische Spannung in die Auswertestruktur ein, welche dadurch eine größere Bewegungsfreiheit aufweist, so dass Materialumlagerungen innerhalb der Auswertestruktur beim Sinterprozess in der Fläche weitgehend unbeeinflusst von statten gehen können.

20 Gemäß einer weiteren sehr bevorzugten Ausführungsform besteht die Deckoxidschicht wenigstens im Bereich der Heizstruktur und des optionalen Temperaturmesswiderstands aus einem unterstöchiometrischen Oxid, um eine relativ gute Anbindung der Deckoxidschicht an die Heizstruktur und den Temperaturmesswiderstand zu erzielen. Hierdurch wird das oben geschilderte Problem der elektrischen Drift der Heizstruktur und des Temperaturmesswiderstands vermieden, da die durch die thermische Stresseinwirkung im Betrieb  
25 des Gassensors hervorgerufenen Materialumlagerungen innerhalb der Heizstruktur und des Temperaturmesswiderstands unterdrückt werden, wodurch eine stabile Funktionsweise über die Einsatzzeit des Gassensors ermöglicht wird.

30 Erfindungsgemäß wird weiter ein Verfahren zum Herstellen eines Gassensors vorgeschlagen, bei dem zunächst ein Halbleitersubstrat bereitgestellt, auf dessen Vorderseite eine Membranschicht aufgebracht und anschließend eine haftvermittelnde Oxidschicht auf der Oberseite der Membranschicht ausgebildet wird. Nachfolgend wird die haftvermittelnde Oxidschicht strukturiert, um einen oxidfreien Auswertebereich auf der Membran bereitzu-

stellen. Danach wird eine gegenüber einer Oxidätzung unempfindliche Haftvermittlerschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats aufgebracht und diese außerhalb des Auswertebereichs entfernt. Als Nächstes erfolgt das Aufbringen einer Metallisierungsschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats, welche außerhalb des Auswertebereichs auf der haftvermittelnden Oxidschicht in eine Heizstruktur und im Auswertebereich auf der Haftvermittlerschicht in eine Auswertestruktur strukturiert wird. Nachfolgend wird eine Deckoxidschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats aufgebracht und diese im Auswertebereich großflächig geätzt, um die Oberfläche der Auswertestruktur freizulegen. Danach wird die Rückseite des Halbleitersubstrats bis zur Erreichung der Membranschicht geätzt und anschließend eine gassensitive Schicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats aufgebracht. 5

10

Mit Hilfe dieses Verfahrens lässt sich der oben beschriebene Gassensor mit einer Haftvermittlerschicht im Auswertebereich herstellen. Durch die zusätzliche Haftvermittlerschicht wird ein Unterätzen der Auswertestruktur bei der Oxidätzung der Deckoxidschicht vermieden, wodurch eine dauerhafte Haftung der Auswertestruktur auf der Membranschicht und damit eine zuverlässige Funktionsweise des Gassensors ermöglicht wird. 15

Erfindungsgemäß wird des weiteren ein Verfahren zum Herstellen eines Gassensors vorgeschlagen, bei dem zu Beginn ein Halbleitersubstrat bereitgestellt, auf dessen Vorderseite eine Membranschicht aufgebracht und anschließend eine haftvermittelnde Oxidschicht auf der Oberseite der Membranschicht ausgebildet wird. Anschließend wird eine Metallisierungsschicht auf der haftvermittelnden Oxidschicht aufgebracht und diese danach in eine Heizstruktur und eine Auswertestruktur strukturiert. Als Nächstes erfolgt das Aufbringen einer Deckoxidschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats. Danach werden in die Deckoxidschicht Kontaktlöcher geätzt, welche jeweils einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur freilegen. Danach wird die Rückseite des Halbleitersubstrats bis zur Erreichung der Membranschicht geätzt und anschließend eine gassensitive Schicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats aufgebracht. 20

25

30 Dieses Verfahren ermöglicht das Herstellen des oben beschriebenen Gassensors mit Kontaktlöchern in der Deckoxidschicht. Da die Kontaktlöcher derart geätzt werden, dass diese jeweils nur einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur freilegen und die

seitlichen Bereiche der Auswertestruktur weiterhin von der Deckoxidschicht bedeckt sind, wird ein Anätzen der unterhalb der Auswertestruktur befindlichen haftvermittelnden Oxidschicht vermieden, wodurch sich wiederum eine beständige Haftung der Auswertestruktur auf der Membranschicht und damit eine zuverlässige Funktionsweise des Gassensors er-  
5 gibt.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird die gassensitive Schicht in pastöser Form auf-  
gebracht und anschließend gesintert. In die zunächst in pastöser Form vorliegende gassen-  
10 sitive Schicht können vorab gezielt unterschiedliche Dotierstoffe eingebracht werden, um die Selektivität für einzelne Gase einzustellen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 eine schematische Darstellung eines Gassensors in einer Aufsicht,
- Figur 2 ein Schnittbild einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors,
- Figur 3 ein Schnittbild einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors, und
- Figur 4 ein Schnittbild einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der Strukturen eines vom Stand der Technik 15 her bekannten Gassensors 1 in einer Aufsicht. Der Gassensor 1 weist außen eine im wesentlichen kreisförmige mäanderartig ausgebildete metallische Heizstruktur 9 auf, welche über Zuleitungen 15 mit elektrischer Energie versorgt werden kann. Innerhalb der Heizstruktur 9 ist eine kreisförmig begrenzte metallische Auswertestruktur 7 angeordnet, bei 20 der ebenfalls elektrische Zuleitungen 14 vorgesehen sind. Diese Strukturen 7, 9 sind auf einer nicht dargestellten Membranschicht auf einem Halbleitersubstrat angeordnet, wodurch die Wärmekapazität des Gesamtsystems und damit die Leistungsaufnahme des Gas-  
sensors 1 verringert wird.

Auf der Heizstruktur 9 und der Auswertestruktur 7 ist eine in Figur 1 nicht dargestellte 25 gassensitive Schicht aufgebracht, welche im wesentlichen die gesamte von der Heizstruktur 9 begrenzte Fläche abdeckt. Die gassensitive Schicht, welche über die Heizstruktur 9

auf eine Betriebstemperatur von mehreren hundert Grad Celsius aufgeheizt werden kann, ändert ihren Widerstand bei Beaufschlagung mit reduzierenden oder oxidierenden Gasen. Diese Widerstandsänderung wird als Messsignal von der Auswertestruktur 7 ausgewertet.

5 Da die gassensitive Schicht in der Regel einen sehr hohen Widerstand aufweist, ist die Auswertestruktur 7 als Interdigitalstruktur mit zwei koplanaren fingerartig ineinandergrif- fenden Elektroden ausgebildet. Diese Ausgestaltung entspricht einer Parallelschaltung der zwischen den einzelnen Elektrodenfingern unterschiedlicher Polarität gebildeten Wider- stände, wodurch der Messwiderstand der gassensitiven Schicht verringert und die Emp-  
10 findlichkeit des Gassensors 1 erhöht wird.

Um eine ausreichende Haftung der Heizstruktur 9, der Auswertestruktur 7 und der Zulei- tungen 14, 15 auf der Membranschicht zu gewährleisten, ist die Oberfläche der Membran- schicht mit einer haftvermittelnden Oxidschicht versehen. Zur Isolierung der Heizstruktur  
15 9 ist zwischen der Heizstruktur 9 und der gassensitiven Schicht eine Deckoxidschicht aus- gebildet, welche sich weiter auch auf den Zuleitungen 14, 15 bis zu nicht dargestellten Kontaktierungs- oder Bondflächen der Zuleitungen 14, 15 erstreckt. Bei der Herstellung des Gassensors 1 wird diese Deckoxidschicht in der Regel im Rahmen eines CVD-  
Abscheideprozesses („Chemical vapour deposition“) ganzflächig auf die bereits auf der  
20 Membranschicht strukturierte Heizstruktur 9 und Auswertestruktur 7 sowie die Zuleitun- gen 14, 15 aufgebracht. Nachfolgend wird die Deckoxidschicht in einem Auswertebereich 8, in Figur 1 durch den gestrichelten Kreis gekennzeichnet, ganzflächig von der Oberfläche der Auswertestruktur 7 entfernt, um eine Kontaktierung der Auswertestruktur 7 mit der später aufgebrachten gassensitiven Schicht zu ermöglichen.

25 Das Entfernen erfolgt in der Regel mittels eines nasschemischen Ätzprozesses, bei dem beispielsweise Flusssäure als Ätzlösung eingesetzt wird. Da die aufgebrachte Deckoxid- schicht bedingt durch Abscheideinhomogenitäten an unterschiedlichen Stellen unter- schiedliche Dicken aufweisen kann, wird der Ätzprozess zumeist mit einer Überätzzeit  
30 durchgeführt, um zu gewährleisten, dass die gesamte Oberfläche der Auswertestruktur 7 in dem Auswertebereich 8 von dem Deckoxid freigelegt wird.

Das Ansetzen einer Überätzzeit birgt jedoch die Gefahr eines Unterätzens der Auswertestruktur 7, da die eingesetzte Ätzlösung über die Bereiche zwischen den Elektrodenfingern die haftvermittelnde Oxidschicht unterhalb der Auswertestruktur 7 erreichen und diese Schicht zum Teil angreifen kann. Dadurch wird die Haftung der Auswertestruktur 7 auf der 5 Membranschicht verringert, so dass sich die Auswertestruktur 7 im Verlauf der Einsatzzeit des Gassensors 1 von dieser ablösen kann und somit eine zuverlässige Funktionsweise des Gassensors 1 nicht mehr sichergestellt ist. Um die Gefahr des Unterätzens der Auswertestruktur 7 zu vermeiden, existieren unterschiedliche erfindungsgemäße Ausführungen eines Gassensors, welche anhand der folgenden Figuren erläutert werden.

10

Figur 2 zeigt ein Schnittbild einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors. Der Gassensor 1a weist ein beispielsweise aus Silizium bestehendes Halbleitersubstrat 2 mit einer Aushöhlung 21 auf, auf welchem eine Membranschicht 3 angeordnet ist. Die Membranschicht 3 ist als Schichtenfolge einer an das Halbleitersubstrat 2 angrenzenden Oxidschicht 4 und einer Nitridschicht 5 ausgebildet und weist außerhalb eines Auswertebereichs 8 auf der Oberseite eine haftvermittelnde Oxidschicht 6 auf.

20 Auf der haftvermittelnden Oxidschicht 6 ist eine metallische Heizstruktur 9 sowie im Bereich der Heizstruktur 9 ein in Figur 2 nicht dargestellter Temperaturmesswiderstand angeordnet. Auf der Heizstruktur 9 und dem Temperaturmesswiderstand befindet sich weiter eine Deckoxidschicht 11 zur Isolierung. Innerhalb des Auswertebereichs 8 ist eine als Interdigitalstruktur ausgebildete metallische Auswertestruktur 7 mit Elektrodenfingern angeordnet. Auf diese Strukturen ist eine gassensitive Schicht 10 aufgebracht, welche von der Heizstruktur 9 beheizbar und deren elektrischer Widerstand von der Auswertestruktur 7 25 auswertbar ist. Mit Hilfe des Temperaturmesswiderstands und eines ebenfalls in Figur 2 nicht dargestellten auf dem massiven Substrat 2 angeordneten Referenzwiderstands lässt sich die Betriebstemperatur des Gassensors 1a überwachen.

30 Als Material für die metallischen Strukturen, die Auswertestruktur 7, die Heizstruktur 9 und den Temperaturmesswiderstand wird vorzugsweise Platin eingesetzt. Dieses Material zeichnet sich durch einen hohen Temperaturkoeffizienten des Widerstands aus, wodurch einerseits die Heizleistung der Heizstruktur 9 gut einstellbar als auch die Temperatur des Gassensors 1a über den Temperaturmesswiderstand mit einer hohen Genauigkeit messbar

ist. Zudem handelt es sich bei Platin um ein inertes Material mit einer hohen chemischen Stabilität.

Im Unterschied zu einem vom Stand der Technik her bekannten Gassensor ist die Aus-

5       wertestruktur 7 auf einer gegenüber einer Oxidätzung unempfindlichen Haftvermittlerschicht 13 angeordnet. Diese Haftvermittlerschicht 13, welche beispielsweise aus Silizium besteht, ist entsprechend der Auswertestruktur 7 strukturiert, um störende Kriechströme zwischen den einzelnen Elektrodenfingern der Auswertestruktur 7 zu vermeiden.

10      Anhand des nachfolgend geschilderten erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens dieses Gassensors 1a lässt sich die vorteilhafte Wirkung der Haftvermittlerschicht 13 erläutern.

Zu Beginn wird das Halbleitersubstrat 2 bereit gestellt und auf dessen Vorderseite die O-  
xidschicht 4 und die Nitridschicht 5 zur Bildung der Membranschicht 3 aufgebracht. Die  
Oxidschicht 4 kann hierbei beispielsweise durch eine thermische Oxidation des Halblei-  
15     terwafers 2 erzeugt und die Nitridschicht 5 mit Hilfe eines CVD-Abscheideverfahrens auf-  
gebracht werden. Anschließend wird die haftvermittelnde Oxidschicht 6 ganzflächig auf  
der Oberseite der Membranschicht 3 ausgebildet, was durch eine als Reoxidation bezeich-  
nete oberflächliche thermische Umwandlung der Nitridschicht 5 oder eine CVD-  
Oxidabscheidung möglich ist.

20      Die haftvermittelnde Oxidschicht 6 wird nachfolgend mittels einer Oxidätzung derart strukturiert, dass der oxidfreie Auswertebereich 8 auf der Membranschicht 3 bereitgestellt wird. Als nächstes wird die gegenüber einer Oxidätzung unempfindliche Haftvermittlerschicht 13 ganzflächig auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats 2 aufgebracht, außerhalb  
25     des Auswertebereichs 8 entfernt und innerhalb des Auswertebereichs 8 entsprechend der später ausgebildeten Auswertestruktur 7 strukturiert, was beispielsweise mit Hilfe eines Ionenstrahlätzprozesses durchgeführt werden kann.

30      Anschließend wird eine Metallisierungsschicht ganzflächig auf die Vorderseite des Halb-  
leitersubstrats 2 aufgebracht und diese in die Heizstruktur 9 und den Temperaturmesswi-  
derstand außerhalb des Auswertebereichs 8 und in die Auswertestruktur 7 innerhalb des Auswertebereichs 8 strukturiert. Das Strukturieren kann wiederum mittels eines Ionen-  
strahlätzprozesses durchgeführt werden. Danach wird die Deckoxidschicht 11 ganzflächig

über einen CVD-Abscheideprozess auf die Vorderseite des Halbleitersubstrats 2 aufgebracht.

Um die Oberfläche der Auswertestruktur 7 freizulegen wird die Deckoxidschicht 11 nach-  
5 folgend durch einen nasschemischen Ätzprozess beispielsweise mit Flusssäure als Ätzlösung großflächig im Auswertebereich 8 entfernt. Da die Auswertestruktur 7 auf der gegenüber dieser Oxidätzung unempfindlichen Haftvermittlerschicht 13 angeordnet ist, wird die Gefahr eines Unterätzens der Auswertestruktur 7 vermieden. Auch tritt kein Unterätzen der Haftvermittlerschicht 13 auf, wenn wie in Figur 2 dargestellt die gesamte Deckoxidschicht  
10 11 bis zur Nitridschicht 5 der Membranschicht 3 weggeätzt wird, da die Nitridschicht 5 ebenfalls unempfindlich gegenüber der nasschemischen Oxidätzung ist. Der Einsatz der Haftvermittlerschicht 13 führt folglich zu einer sicheren Haftung der Auswertestruktur 7 auf der Membranschicht 3 und begünstigt damit eine zuverlässige Funktionsweise des Gassensors 1a.

15 Im darauffolgenden Verfahrensschritt wird die Rückseite des Halbleitersubstrats 2 beispielsweise mit Hilfe von Kalilauge bis zur Erreichung der Membranschicht 3 geätzt, so dass die Aushöhlung 21 entsteht. Die Oxidschicht 4, welche eine gegenüber dem Halbleitersubstrat 2 stark reduzierte Ätzrate aufweist, fungiert hierbei als Ätzstopp, auf welchem der Ätzvorgang gezielt gestoppt werden kann. Abschließend wird die gassensitive Schicht 10 auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats 2 erzeugt. Die gassensitive Schicht 10 wird dabei zunächst in pastöser Form, beispielsweise mit Hilfe eines Siebdruck- oder Dispens-  
20 verfahrens, aufgebracht und anschließend gesintert. Die gassensitive Schicht 10 kann Dotierstoffe enthalten, wodurch der Gassensor 1a zum Nachweis spezifischer Gase sensitiv  
25 ist. Möglich ist es auch, die gassensitive Schicht per Sputter – oder CVD-Verfahren aufzubringen und optional zu sintern.

Alternativ können Abwandlungen des beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen des in Figur 2 dargestellten erfindungsgemäßen Gassensors 1a durchgeführt  
30 werden. Beispielsweise ist es möglich, die ganzflächig auf der Vorderseite des Halbleiter- substrats 2 aufgebrachte Haftvermittlerschicht 13 zunächst nur außerhalb des Auswertebe- reichs 8 zu entfernen und dann gleichzeitig mit der Auswertestruktur 7 zu strukturieren. Auch ist es möglich, die gassensitive Schicht 10 vor dem Rückseitenätzen des Halbleiter-

substrats 2 aufzubringen, sofern die gassensitive Schicht 10 sicher vor einem Ätzangriff geschützt wird.

Das vom Stand der Technik her bekannte Problem des Unterätzens der Auswertestruktur 7 beim Herstellungsverfahren kann weiter durch die in Figur 3 dargestellte zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors vermieden werden. Bei diesem Gassensor 1b ist im Unterschied zu dem in Figur 2 dargestellten Gassensor 1a die haftvermittelnde Oxidschicht 6 auf der Oberseite der Membranschicht 3 nicht strukturiert und befindet sich weiterhin im Auswertebereich 8 unterhalb der Auswertestruktur 7. Auch die Deckoxid-  
schicht 11 erstreckt sich über den Auswertebereich 8 und weist Kontaktlöcher 12 auf, welche jeweils nur einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur 7 freilegen.

Bei der Herstellung dieses Gassensors 1b wird nach dem Aufbringen der aus der Oxidschicht 4 und der Nitridschicht 5 gebildeten Membranschicht 3 auf das bereitgestellte Halbleitersubstrat 2 und dem Ausbilden der haftvermittelnden Oxidschicht 6 auf der Oberseite der Membranschicht 3 wiederum eine Metallisierungsschicht abgeschieden und diese entsprechend in die Heizstruktur 9, die Auswertestruktur 7 und den Temperaturmesswiderstand strukturiert.

Nachfolgend wird die Deckoxidschicht 11 ganzflächig auf der Vorderseite des Halbleiter-  
substrats 2 abgeschieden. Mit Hilfe eines nasschemischen Ätzprozesses werden anschlie-  
ßend die Kontaktlöcher 12 in die Deckoxidschicht 11 geätzt, welche jeweils nur einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur 7 freilegen, so dass die Oberflächen der Elektrodenfinger der Auswertestruktur 7 an den Seiten weiterhin mit der Deckoxid-  
schicht 11 bedeckt sind. Hierdurch wird vermieden, dass die bei der Oxidätzung einge-  
setzte Ätzlösung die haftvermittelnde Oxidschicht 6 unterhalb der Auswertestruktur 7 er-  
reicht und diese angreift, so dass wiederum eine sichere Haftung der Auswertestruktur 7 auf der Membranschicht 3 erzielt wird. Abschließend werden bei diesem Gassensor 1b entsprechend das Rückseitenätzen des Halbleitersubstrats 2 und das Aufbringen der gas-  
sensitiven Schicht 10 auf die Vorderseite des Halbleitersubstrats 2 durchgeführt, wobei die gassensitive Schicht 10 auch in die Kontaktlöcher 12 eingebracht wird.

Der in Figur 3 dargestellte erfindungsgemäße Gassensor 1b hat gegenüber dem in Figur 2 dargestellten erfindungsgemäßen Gassensor 1a den Nachteil, dass sich aufgrund von Justagetoleranzen zwischen den für die Strukturierung der Auswertestruktur 7 und für das Ätzen der Kontaktlöcher 12 benötigten Masken nur größere Abstände zwischen den einzelnen

5 Elektrodenfingern der Auswertestruktur 7 realisieren lassen, wodurch der Gassensor 1b weniger empfindlich ist. Denn je größer der Abstand zwischen den einzelnen Elektrodenfingern ist, desto größer ist der Messwiderstand, da einerseits der zwischen den Elektrodenfingern gemessene längenabhängige Widerstand größer wird als auch andererseits weniger Elektrodenfinger und damit weniger Parallelschaltungen auf einer gegebenen Fläche

10 realisiert werden können.

Das Problem der elektrischen Drift ist die Folge einer thermomechanischen Stresseinwirkung, da die Gassensoren 1a, 1b im Betrieb in einem permanenten Zyklus zwischen Umgebungstemperatur und Betriebstemperatur arbeiten, wodurch es zu Materialumlagerungen

15 innerhalb der metallischen Strukturen verbunden mit Widerstandsänderungen kommen kann.

Bei der Auswertestruktur 7 kann die hieraus resultierende Widerstandsänderung aufgrund des hohen Messwiderstands der gassensitiven Schicht 10 wiederum vernachlässigt werden.

20 Bei der Heizstruktur 9, welche einen Widerstand beispielsweise im  $\Omega$ -bereich aufweist, kann die Widerstandsänderung jedoch zu einer deutlichen Veränderung der Heizleistung und damit der Betriebstemperatur der Gassensoren 1a, 1b führen. Dies gilt entsprechend für den im Bereich der Heizstruktur 9 angeordneten Temperaturmesswiderstand, wodurch die exakte Temperatur der Gassensoren 1a, 1b nicht mehr bestimmt werden kann und so

25 mit eine zuverlässige stabile Funktionsweise über die Einsatzzeit der Gassensoren 1a, 1b nicht mehr gewährleistet ist.

Das Problem der elektrischen Drift ist bei der in Figur 4 dargestellten dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassensors, welche auf der in Figur 3 dargestellten Ausführungsform aufbaut, weitgehend unterdrückt.

Bei diesem Gassensor 1c wird eine zweilagige Deckoxidschicht 11 eingesetzt, welche im Bereich der driftempfindlichen Heizstruktur 9, des Temperaturmesswiderstands und deren

elektrischen Zuleitungen aus einer unterstöchiometrischen Oxidschicht 11a besteht, im Falle einer Silizium-Deckoxidschicht also aus einem siliziumreichen Oxid, über welcher eine eher stöchiometrische Oxidschicht 11b angeordnet ist. Diese Deckoxidschicht 11 könnte beispielsweise durch ganzflächiges Abscheiden der unterstöchiometrischen Oxidschicht 11a auf die Oberseite der Membranschicht 3 mit den bereits ausgebildeten metallischen Strukturen, anschließendes Strukturieren der unterstöchiometrischen Oxidschicht 11a und nachfolgendes ganzflächiges Abscheiden der stöchiometrischen Oxidschicht 11b erzeugt werden. Das Aufbringen der beiden Oxidschichten 11a, 11b ist wiederum mit Hilfe von CVD-Abscheideverfahren möglich.

10

Die unterstöchiometrische Oxidschicht 11a zeichnet sich durch eine relativ gute Anbindung an die Heizstruktur 9 und den Temperaturmesswiderstand aus, wodurch Materialumlagerungen aufgrund von thermischer Stresseinwirkung innerhalb der Heizstruktur 9 und des Temperaturmesswiderstands einhergehend mit Widerstandsänderungen unterdrückt werden. Infolgedessen wird eine stabile Funktionsweise über die Einsatzzeit des Gassensors 1c ermöglicht.

Die auf die unterstöchiometrische Oxidschicht 11a und auch auf die Auswertestruktur 7 aufgebrachte stöchiometrische Oxidschicht 11b, welche entsprechend der in Figur 3 dargestellten Ausführungsform mit Kontaktlöchern 12 versehen ist, erweist sich als sehr günstig für die Auswertestruktur 7 beim Sinterprozess der gassensitiven Schicht 10. Aufgrund der bei diesem Prozess vorherrschenden hohen Temperaturen treten an den Übergangsbereichen zwischen der durch die Deckoxidschicht 11 bedeckten und der über die Kontaktlöcher 12 freigelegten Oberfläche der Auswertestruktur 7 unterschiedliche thermomechanische Spannungen auf, welche Materialumlagerungen innerhalb der Auswertestruktur 7 hervorrufen können. Die stöchiometrische Oxidschicht 11b, welche eine schlechtere Anbindung an die Auswertestruktur 7 aufweist als eine aus einem unterstöchiometrischen Oxid bestehende Schicht, koppelt folglich eine geringe thermische Spannung in die Auswertestruktur 7 ein, so dass bei einem Sinterprozess Materialumlagerungen innerhalb der Auswertestruktur 7 als weniger kritisch angesehen werden können.

An Stelle der beschriebenen Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Gassensors sind Ausführungsformen vorstellbar, die weitere Kombinationen der in den Figuren 2 bis 4

dargestellten Ausführungsformen darstellen. Beispielsweise könnte bei dem in Figur 2 dargestellten Gassensor 1a die Deckoxidschicht 11 als unterstöchiometrische Oxidschicht ausgebildet sein, um die elektrische Drift bei der Heizstruktur 9 und dem Temperaturmesswiderstand zu vermeiden.

5

Generell ist es sinnvoll, bei einem Gassensor die driftempfindlichen metallischen Strukturen mit einer unterstöchiometrischen Oxidschicht abzudecken und an den Übergangsbereichen zwischen bedeckten und freiliegenden Oberflächen der Strukturen ein stöchiometrisches Oxid zu verwenden, um die Sinterfestigkeit zu erhöhen. Dies gilt beispielsweise auch 10 für die Zuleitungen der metallischen Strukturen, bei welchen der Einsatz eines stöchiometrischen Deckoxids angrenzend an die nichtabgedeckten Kontaktierungsflächen vorteilhaft ist.

Das anhand von Figur 4 offenbare Merkmal, eine unterstöchiometrische Oxidschicht als 15 Deckoxidschicht für driftempfindliche Strukturen einzusetzen, kann auch als eigenständiges Merkmal eines Gassensors realisiert sein. Möglich ist es auch, dieses Merkmal bei anderen Sensoren wie beispielsweise Luftmassensensoren zu verwirklichen.

20

## Patentansprüche

5

1. Gassensor mit einer auf einem Halbleitersubstrat (2) ausgebildeten Membranschicht (3), auf der eine metallische Auswertestruktur (7) in einem Auswertebereich (8) und eine metallische Heizstruktur (9) außerhalb des Auswertebereichs (8) angeordnet sind, und mit einer über der Auswertestruktur (7) und der Heizstruktur (9) angeordneten gassensitiven Schicht (10), wobei die gassensitive Schicht (10) von der Heizstruktur (9) beheizbar und der elektrische Widerstand der gassensitiven Schicht (10) von der Auswertestruktur (7) auswertbar ist und wobei die Heizstruktur (9) auf einer haftvermittelnden Oxidschicht (6) auf der Oberseite der Membranschicht (3) angeordnet und durch eine Deckoxidschicht (11) von der gassensitiven Schicht (10) getrennt ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in dem Auswertebereich (8) eine gegenüber einer Oxidätzung unempfindliche Haftvermittlerschicht (13) zwischen der Membranschicht (3) und der Auswertestruktur (7) angeordnet ist.

10

15

20

2. Gassensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftvermittlerschicht (13) entsprechend der Auswertestruktur (7) strukturiert ist.

25

30

3. Gassensor mit einer auf einem Halbleitersubstrat (2) ausgebildeten Membranschicht (3), auf der eine metallische Auswertestruktur (7) in einem Auswertebereich (8) und eine metallische Heizstruktur (9) außerhalb des Auswertebereichs (8) angeordnet sind, und mit einer über der Auswertestruktur (7) und der Heizstruktur (9) angeordneten gassensitiven Schicht (10), wobei die gassensitive Schicht (10) von der Heizstruktur (9) beheizbar und der elektrische Widerstand der gassensitiven Schicht (10) von der Auswertestruktur (7) auswertbar ist und wobei die Heizstruktur (9) auf einer haftvermittelnden Oxidschicht (6) auf der Oberseite der Membranschicht (3) angeordnet und durch eine Deckoxidschicht (11) von der gassensitiven Schicht getrennt ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Auswertestruktur (7) in dem Auswertebereich (8) entsprechend der Heiz-

struktur (9) durch die Deckoxidschicht (11) von der gassensitiven Schicht (10) getrennt ist, wobei die Deckoxidschicht (11) Kontaktlöcher (12) aufweist, welche jeweils einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur (7) freilegen, um einen direkten Kontakt zwischen der Auswertestruktur (7) und der gassensitiven Schicht (10) herzustellen.

5

4. Gassensor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckoxidschicht (11) wenigstens in dem Auswertebereich (8) der Auswertestruktur (7) aus einem stöchiometrischen Oxid besteht.

10

5. Gassensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckoxidschicht (11) wenigstens im Bereich der Heizstruktur (9) aus einem unterstöchiometrischen Oxid besteht, um eine relativ gute Anbindung der Deckoxidschicht (11) an die Heizstruktur (9) zu erzielen.

15

6. Gassensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Membranschicht (3) von einer Nitridschicht (5) gebildet wird, welche vorzugsweise eine an das Halbleitersubstrat (2) angrenzende Oxidschicht (4) aufweist.

20

7. Gassensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Temperaturmesswiderstand auf der haftvermittelnden Oxidschicht (6) im Bereich der Heizstruktur (9) vorgesehen ist.

25

8. Gassensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertestruktur (7), die Heizstruktur (9) und der Temperaturmesswiderstand aus dem gleichen metallischen Material, vorzugsweise Platin, bestehen.

30

9. Gassensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertestruktur (7) als Interdigitalstruktur mit zwei koplanaren, fingerartig ineinander greifenden Elektroden ausgebildet ist.

10. Verfahren zum Herstellen eines Gassensors gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

- a) Bereitstellen eines Halbleitersubstrats (2);
- b) Aufbringen einer Membranschicht (3) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- c) Ausbilden einer haftvermittelnden Oxidschicht (6) auf der Oberseite der Membranschicht (3);
- 5 d) Strukturieren der haftvermittelnden Oxidschicht (6), um einen oxidfreien Auswertebereich (8) auf der Membranschicht (3) bereitzustellen;
- e) Aufbringen einer gegenüber einer Oxidätzung unempfindlichen Haftvermittlerschicht (13) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- 10 f) Entfernen der Haftvermittlerschicht (13) außerhalb des Auswertebereichs (8);
- g) Aufbringen einer Metallisierungsschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- h) Strukturieren einer Heizstruktur (9) außerhalb des Auswertebereichs (8) auf der haftvermittelnden Oxidschicht (6) und einer Auswertestruktur (7) im Auswertebereich (8) auf der Haftvermittlerschicht (13);
- 15 i) Aufbringen einer Deckoxidschicht (11) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- j) Großflächiges Oxidätzen der Deckoxidschicht (11) im Auswertebereich (8), um die Oberfläche der Auswertestruktur (7) freizulegen;
- 20 k) Ätzen der Rückseite des Halbleitersubstrats (2) bis zur Erreichung der Membranschicht (3); und
- l) Aufbringen einer gassensitiven Schicht (10) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2).

25 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftvermittlerschicht (13) zusätzlich entsprechend der Auswertestruktur (7) strukturiert wird.

12. Verfahren zum Herstellen eines Gassensors gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

- 30 a) Bereitstellen eines Halbleitersubstrats (2);
- b) Aufbringen einer Membranschicht (3) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- c) Ausbilden einer haftvermittelnden Oxidschicht (6) auf der Oberseite der Membran-

schicht (3);

- d) Aufbringen einer Metallisierungsschicht auf der haftvermittelnden Oxidschicht (6);
- e) Strukturieren einer Heizstruktur (9) und einer Auswertestruktur (7);
- f) Aufbringen einer Deckoxidschicht (11) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2);
- 5 g) Oxidätzen von Kontaktlöchern (12) in die Deckoxidschicht (11), welche jeweils einen mittleren Bereich der Oberfläche der Auswertestruktur (7) freilegen;
- h) Ätzen der Rückseite des Halbleitersubstrats (2) bis zur Erreichung der Membranschicht (3); und
- 10 i) Aufbringen einer gassensitiven Schicht (10) auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (2).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckoxidschicht (11) wenigstens im Auswertebereich (8) aus einer stöchiometrischen Oxidschicht (11b) besteht.

15

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckoxidschicht (11) wenigstens im Bereich der Heizstruktur (9) aus einer unterstöchiometrischen Oxidschicht (11a) besteht, um eine relativ gute Anbindung der Deckoxidschicht (11) an die Heizstruktur (9) zu erzielen.

20

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Membranschicht (3) von einer Nitridschicht (5) gebildet wird, welche vorzugsweise eine an das Halbleitersubstrat (2) angrenzende Oxidschicht (4) aufweist.

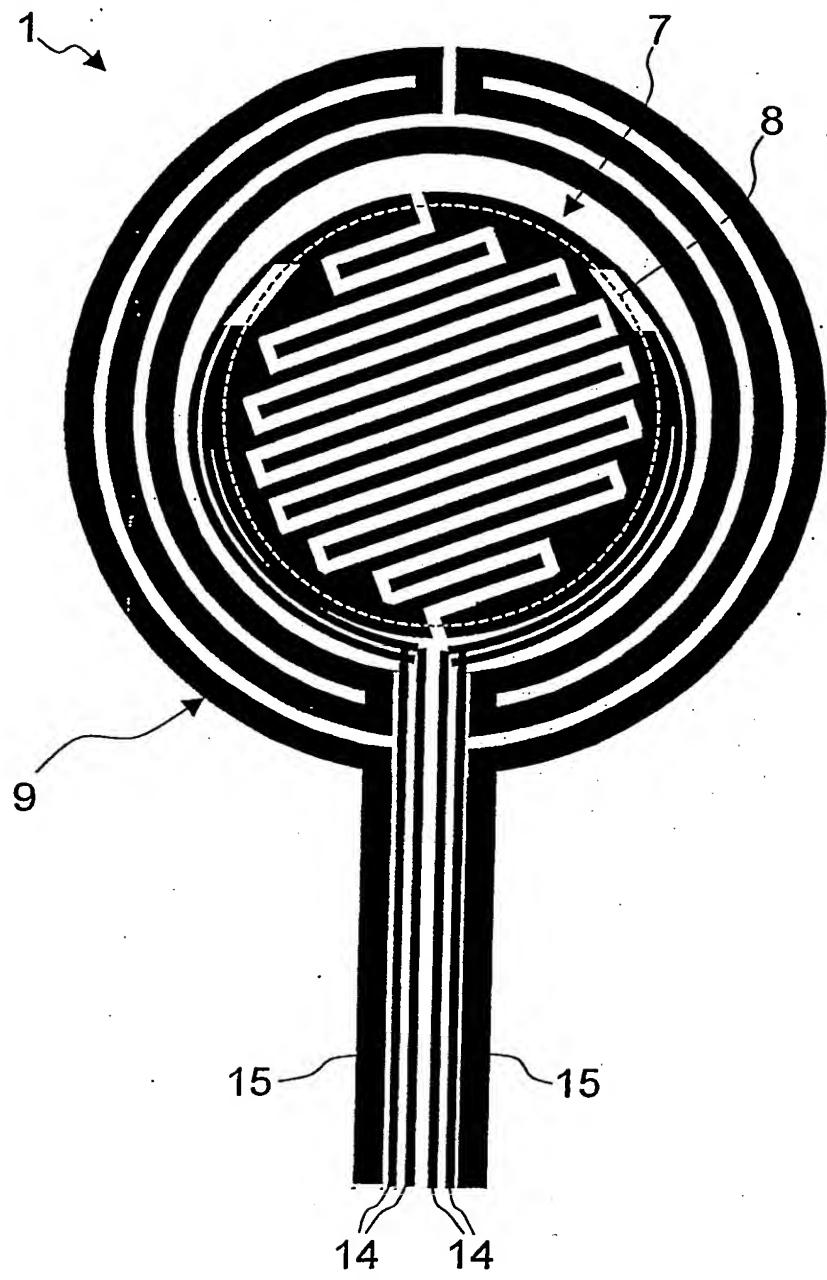
25

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Temperaturmesswiderstand auf der haftvermittelnden Oxidschicht (6) im Bereich der Heizstruktur (9) strukturiert wird.

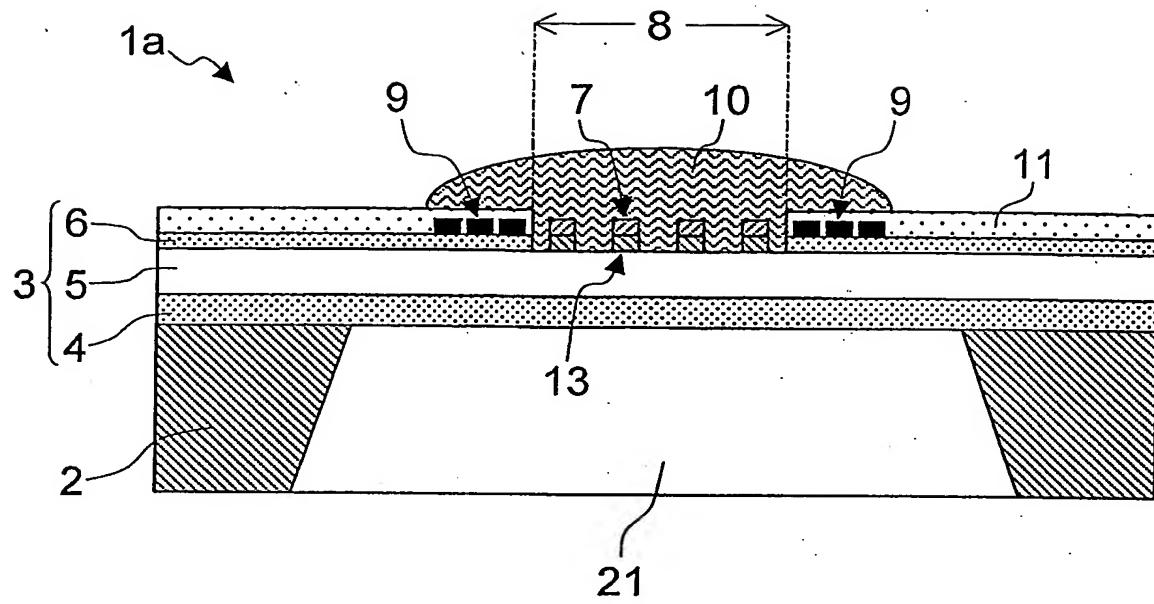
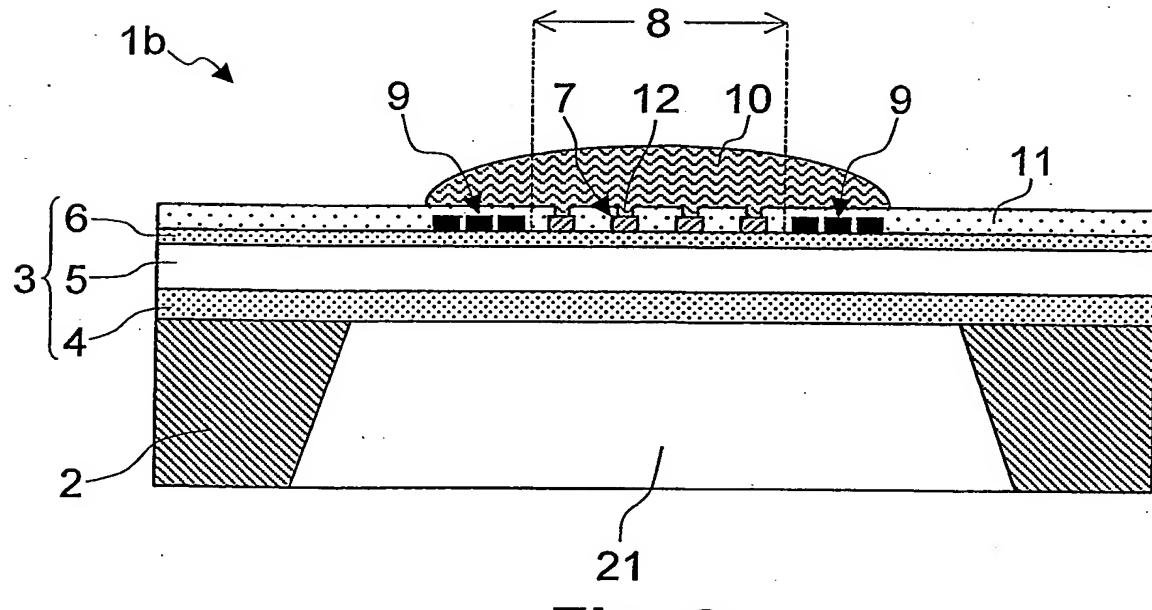
30

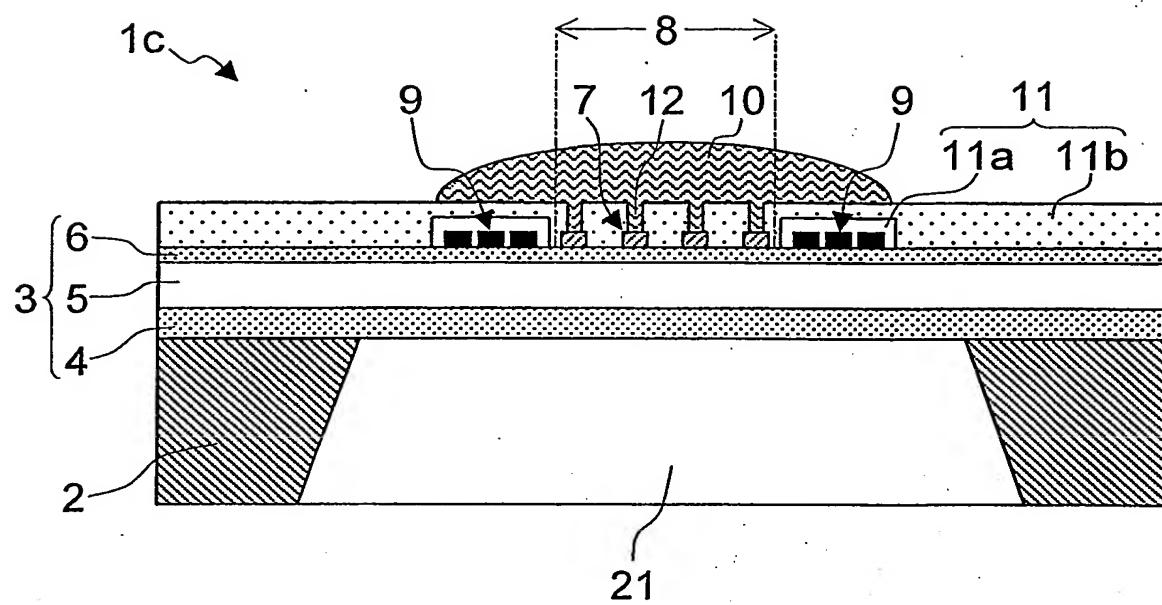
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die gas-sensitive Schicht (10) in pastöser Form aufgebracht und anschließend gesintert wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die gas-sensitive Schicht per Sputter – oder CVD-Verfahren aufgebracht und optional gesintert wird.



**Fig. 1**

**Fig. 2****Fig. 3**



**Fig. 4**

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/001645

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 IPC 7 G01N27/12 G01N27/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category <sup>o</sup>	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 197 10 358 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24 September 1998 (1998-09-24) the whole document	1,2,7-9
A	US 5 345 213 A (SUEHLE JOHN S ET AL) 6 September 1994 (1994-09-06) column 8, line 49 - column 9, line 11; figure 4	3,10-12, 16-18
X	US 2003/039586 A1 (TOYODA INAO ET AL) 27 February 2003 (2003-02-27) abstract	3,4,12, 13
Y	paragraphs '0018! - '0020!, '0022!, '0023!, '0025! - '0030!, '0032!; figures 1-6	1,2,6-8, 15,16
A	----- -----	10,11
	-----	-----

 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the International filing date
- "L" document which may throw doubts on priority, claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

Date of mailing of the international search report

23 November 2004

01/12/2004

Name and mailing address of the ISA  
 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Meyer, F

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2004/001645

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CHUNG W-Y ET AL: "Thermal and gas-sensing properties of planar-type micro gas sensor" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. 64, no. 1-3, June 2000 (2000-06), pages 118-123, XP004199295 ISSN: 0925-4005 pages 118-119; figures 1,2	1,2,6-8, 15,16

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001645

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19710358	A	24-09-1998		DE 19710358 A1 CH 692870 A5 JP 10267877 A US 6787047 B1		24-09-1998 29-11-2002 09-10-1998 07-09-2004
US 5345213	A	06-09-1994		AU 6120294 A WO 9410559 A2		24-05-1994 11-05-1994
US 2003039586	A1	27-02-2003		JP 2003065990 A DE 10239281 A1		05-03-2003 20-03-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/001645

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G01N27/12 G01N27/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 197 10 358 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24. September 1998 (1998-09-24) das ganze Dokument	1,2,7-9
A		3,10-12, 16-18
X	US 5 345 213 A (SUEHLE JOHN S ET AL) 6. September 1994 (1994-09-06) Spalte 8, Zeile 49 – Spalte 9, Zeile 11; Abbildung 4	3,4,12, 13 1,10
A		
X	US 2003/039586 A1 (TOYODA INAO ET AL) 27. Februar 2003 (2003-02-27)	3,4,12, 13,17
Y	Zusammenfassung	1,2,6-8, 15,16
A	Absätze '0018! – '0020!, '0022!, '0023!, '0025! – '0030!, '0032!; Abbildungen 1-6	10,11
		-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

23. November 2004

01/12/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL – 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax. (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Meyer, F

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/001645

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	CHUNG W-Y ET AL: "Thermal and gas-sensing properties of planar-type micro gas sensor" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, Bd. 64, Nr. 1-3, Juni 2000 (2000-06), Seiten 118-123, XP004199295 ISSN: 0925-4005 Seiten 118-119; Abbildungen 1,2	1,2,6-8, 15,16

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/001645

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19710358	A	24-09-1998	DE CH JP US	19710358 A1 692870 A5 10267877 A 6787047 B1		24-09-1998 29-11-2002 09-10-1998 07-09-2004
US 5345213	A	06-09-1994	AU WO	6120294 A 9410559 A2		24-05-1994 11-05-1994
US 2003039586	A1	27-02-2003	JP DE	2003065990 A 10239281 A1		05-03-2003 20-03-2003